

Silicon Standard Recovery Diode

$V_{RRM} = 50 \text{ V} - 1000 \text{ V}$

$I_F = 12 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 1000 V V_{RRM}

DO-4 Package



Maximum ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	1N3671A (R)	1N3673A (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		800	1000	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		560	700	V
DC blocking voltage	V_{DC}		800	1000	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 150^\circ\text{C}$	12	12	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 8.3 \text{ ms}$	240	240	A
Operating temperature	T_j		-65 to 200	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-65 to 200	-65 to 200	$^\circ\text{C}$

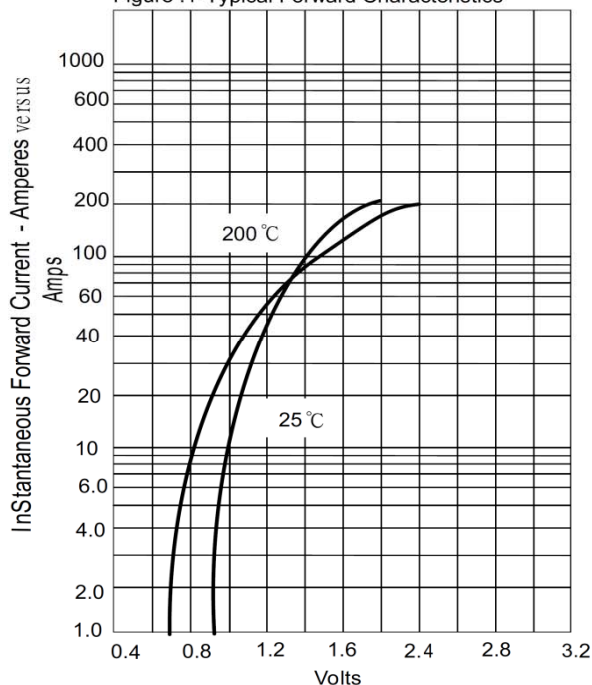
Electrical characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	1N3671A (R)	1N3673A (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 12 \text{ A}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	1.1	1.1	V
Reverse current	I_R	$V_R = 50 \text{ V}$, $T_j = 25^\circ\text{C}$	10	10	μA
		$V_R = 50 \text{ V}$, $T_j = 175^\circ\text{C}$	15	15	mA

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		2.00	2.00	$^\circ\text{C/W}$
-------------------------------------	------------	--	------	------	--------------------

Figure .1-Typical Forward Characteristics



Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure .2- Forward Derating Curve

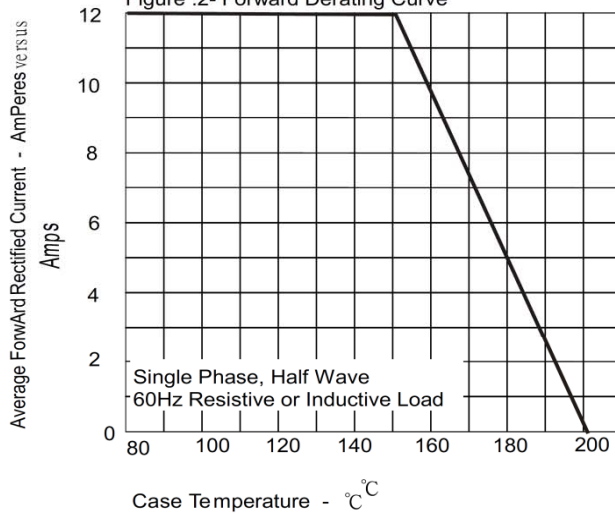


Figure .4-Typical Reverse Characteristics

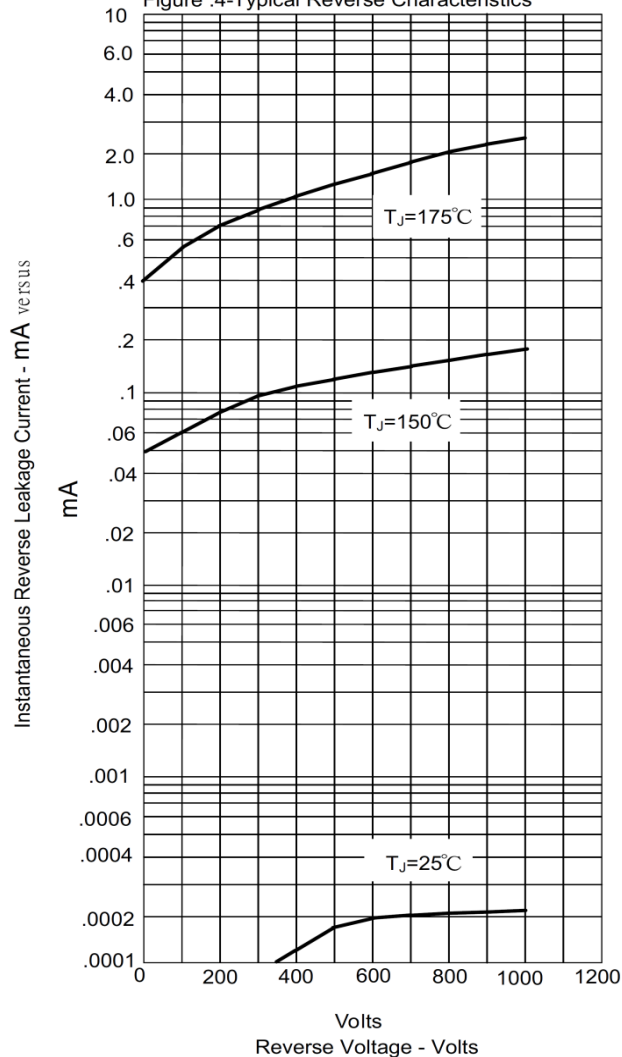
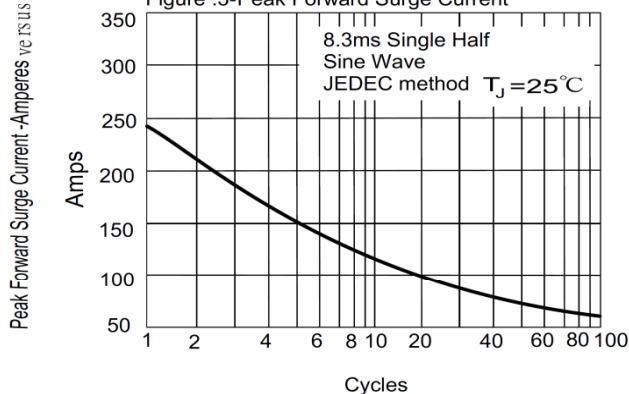


Figure .3-Peak Forward Surge Current



Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9